PAT-NO:

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP363117421A JP 63117421 A

TITLE:

EXPOSURE DEVICE

May 21, 1988

PUBN-DATE:

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIRUKAWA, SHIGERU

SUWA, KYOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY N/A

NIKON CORP APPL-NO:

JP61264314

APPL-DATE: November 6, 1986 INT-CL (IPC): H01L021/30, G03F009/00 , H01L021/68

US-CL-CURRENT: 396/51, 396/FOR.710

ABSTRACT:

PURPOSE: To effectively use light which is even emitted continuously from a light source so that effective use and high throughput of energy can be achieved, by forming a resist removal optical means, in which laser beam is guided on an alignment mark of a wafer when exposure of a reticle pattern is not performed on the <u>wafer</u>, so that the resist on an alignment mark is vaporized by radiation of laser beam emitted from the exposure light source.

CONSTITUTION: Light emitted from a light source 1 is reflected on a movable reflector 2 and further reflected on a reflector 9 and it reaches a shutter 11. When the movable reflector 2 is in a position shown in a solid line, the shutter is opened for a time required to remove a resist, and so the resist is vaporized. During the removal of the resist, position alignment of a wafer 25 is performed. When the shutter 11 is closed, the movable reflector 2 is moved up and the light reaches a shutter 3. When the position alignment of the wafer 25 is completed, the shutter 3 is opened for a fixed time. Light which transmits the shutter 3 passes through a condenser 6 and it illuminates a reticle 7. Then a pattern of the reticle 7 is transcribed on a prescribed chip of the wafer 25.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO& Japio

が不均一になることはさけられない。このためア ライメントマークから発生する光情報がレジスト 層の影響で弱くなったり、薄膜固有の干渉効果が マーク近傍で顕著になったり、あるいはマーク両 側でレジスト膜厚のムラが非対称になったりする こと等によってアライメント特度(マーク位置の 検出特度)が低下しがちであった。

またウェハ上でのパターンの微細化を計るために多層レジストを使う場合等は、アライメントマークそのものが露光波長の照明光のもとで光学的に見えなくなるといった現象を起り得るため、アライメント特度の確保はなかなか難しい問題となっていた。

そこで、露光光源とは別にレジスト層を気化し うる波長とエネルギーとを有するレーザ光を射出 するレーザ光源を設け、このレーザ光によってア ライメントマーク上のレジスト層を除去すること が行なわれている。

(発明が解決しようとする問題点)

上記のような従来の技術においては、単純な露

統的に発光させていても露光光源からの光が有効 に用いられ、エネルギーの有効利用及び高スルー プットが達成できる。

(実施例)

第1図は本発明の第1実施例の光学系を側面から見たブロック図、である。

露光光源1としては、紫外域の波長成分を包含するパルスレーザ光源として、エキシマレーザ(Exciner Laser)が用いられている。光源1の射出光は、可動反射鏡2が図示の位置にあるときは可動反射鏡2で反射するレジスト除去光路を通り、可動反射鏡2が破線の位置にあるときは破線で示した露光光路を通る。

破線で示した露光光路中にはシャッタ3、インテグレータ4、反射鏡5、コンデンサ6、レチクル7、投影レンズ8が配置され、移動ステージ26に載置されているウェハ25の1チップにレチクル7のパターンが写し込まれる。なお、レチクル7とウェハ25と位置合せを行なうために、レチクル7とウェハ25とにそれぞれ設けたアライ

光装置としては露光時以外にはレーザ光は不要となるので、①レーザを発援させ続けながらシャターを閉じておくか、②露光時以外にはレーザ発援を停止させることが考えられるが、①の場合にはエネルギーの無駄であり、②の場合にはレーアの起動にかかる時間分だけスループットが低くでする。 本発明はこれらの欠点を取り除き、ラングコストが低く、高スループットの投影露光装置を得ることを目的とする。

(問題点を解決する為の手段)。

上記問題点の解決の為に本発明では、レチクルのパターンがウェハに露光されていないときに、露光光源を射出したレーザ光をウェハのアライメントマーク上に導くレジスト除去光学手段を設け、露光光源を射出するレーザ光の照射によって、アライメントマーク上のレジストを気化している。(作用)

本発明では、レチクルのパターンがウェハに露 光されていないとき、露光光源がレジスト除去用 の光源として用いられるので、光源からの光を連

メントマークの整合をとるアライメント装置が用いられるが、周知のものであるから図面からは省いてある。

実線で示したレジスト除去光路には、反射鏡9、シャッタ11、絞り12、集光レンズ14、反射鏡15が設けられ、反射鏡15で反射した光が移動ステージ28上のウェハ27上に集光される。このようにして集光された光スポットに対するウェハ27の位置合せを行なうために、ウェハ27上のアライメントマークを検出するアライメントマーク検出手段29、30が反射鏡9、シャッタ11、絞り12、集光レンズ14、反射鏡15と一体に設けられている。

このような構成であるから、ウェハ27上のア ライメントマークをアライメントマーク検出手段 29、30によって検出するように移動ステージ を移動し、まず、レーザ光の照射位置とウェハ2 7上の任意の点との対応づけ(グローバルアライ メント)を行なう。一方、ウェハ25についても 不図示のアライメント装置により、レチクル7と の位置合せが行なわれる。そして、可動反射鏡と が実験の位置にあるとで反射にあるとで反射はした、変化にある。この反射鏡とで反射にある。シャッタ11に至る。シャッタがアッタがででである。シャックを検し、レッタがアックを検し、レッタがでががいる。といるときでは、カースとは、カースを検討している。というないが、では、カースを

上述のシャッタ11が閉じると、可動反射鏡 2 は破線の位置まで上昇する。従って、光源1から の光はシャッタ3に達する。シャッタ3は可動反 射鏡 2 が破線の位置に切換えられ、かつウェハ 2 5 のアライメントマークを用いた位置合せが完了 しているとき、所定時間開放される。シャッタ 3 の透過光は、インテグレータ 4 で均質化され、反

なお、レジスト除去の場合は、ウェハ27とア ライメントマーク検出手段29、30とによって グローバルアライメントのみ行ない、以後は設計 値に基づいたステージ28の送りのみによってと、 反射鏡15で反射されて形成される光スポットと、 ウェハ27の各チップ毎に設けられたアライメン トマークとの位置合せを行ない、値方、露光の場 合はウェハ25の各チップ毎に設けられたアライ メントマークによって各チップ毎にレチクル7と の整合せの精度が大きく異なり、後者の方がより 精確さを要求されるからである。

なお、シャッタ11の開放時間は、アライメントマーク上のレジストが一定の厚さであると仮定し、そのレジストを気化できるだけの時間に設定しておいても良いし、それでは必ずしもすべての場合に対応できないので、反射率やレジストから生する蛍光の変化に基づいてレジストが除去されたか否かを検出する検出器を設け、この検出器か

射鏡5で反射し、コンデンサ6を通ってレチクル7を照明する。レチクル7は投影レンズ8により、投影レンズ8に共役となってもり、投影レンス8の倍率(例えば倍率1/5)に従った少のパターンがウェハ25の所定のチャにのようにして、可動反射鏡でなってウェハ25への露光を行いたではいる間、移動ステージ25が設計値に基づいた所定量移動する。そうすると次にレジストマークが、光スポットの照射される位置に移動する。

以下、可動反射鏡が交互にレジスト除去光路と 電光光路とを選択し、一方の光路が選択されているとき、他方の光路のウェハの位置合せが行なわれ、また、シャッタ3、11がそれぞれの動作に 関連させて一定時間開放される。そして、全ての チップにつきアライメントマーク上のレジストが 除去されたウェハ27は、全てのチップについて 露光の終了したウェハ25の代わりに、不図示の 搬送位置によってステージ26上に載置される。

らの信号によってシャッタ11の閉時刻を制御するようにすれば、レジストの厚みむらによって、レジストが完全に除去されなかったり、ファインアライメントマークを損傷してしまったりすることを避けることができる。

次に第1実施例の電気ブロック図を第2図に示し、説明する。

第1コンピュータ31は露光制御用のコンピュータ、第2コンピュータ32はレジスト除去制御用のコンピュータ、第3コンピュータ33はコンピュータ31、32、反射鏡の挿脱を制御するメインのコンピュータである。

第1コンピュータ31は、駆動装置34を通してステージ26を移動する。一方、アライメント装置35からアライメント信号を入力する。また、第1コンピュータ31はシャック3の開閉を制御する。

第2コンピュータ32は、駆動装置36を適してステージ28を移動する。また、初期設定のためにアライメントマーク検出手段30からのアラ

イメント信号を入力する。第2コンピュータ32 はさらに、シャッタ11の開閉を制御する。

第3コンピュータ33は、司令部37からの指令を受けると共に、反射鏡2の切り換えを行い、さらに、第1コンピュータ31、第2コンピュータ32との間で信号のやりとりを行う。

すなわち、まず第3コンピュータ33は旬令部37から操作開始指令がなされると、反射鏡2をあらかじめた位置に設定する(本例の場合と定する(本例の場合とないでは、第3コンピュータ33は、第1コンピュータ31、第2コンピュータ32に、第1コンピュータ31、第2コンピュータ32に、それぞれが受け持っていることを行なうように関合せを行なう。同じ位置合せでも前者はチップチスともである。はそのカェハ25、27の位置とようではチップチスとはその統計処理によるアライメントはどローバルアライメントを置35、アライメントを置35、アライメントを置35、アライメントを

ないときはそれを待って、また、すでに位置合せが完了した旨の信号が入力されているときはすぐに、シャッタ3を所定時間開放する。そしてシャッタ3が開成されるとコンピュータ33に露光終了信号が送出される。

一方、第3コンピュータ33から第1コンピュータ31に露光開始信号が送出されると同時に、第2コンピュータ32には、次のチップのアライステージ28を所定量移動する信号が送出される。第2コンピュータ32は、あらかじめ設定された。第2コンピュータ32は、あらかじめ設定された。第2コンピュータ32は、あらかで起動装置36はステージ28を所定という。変動装置36はステージ28を所定があります。たけ動かす。その結果、次のチップのアライメストマーク上に光スポットが生ずるように、ウェハ27が移動する。

従って、第1コンピュータ31からの露光終了信号によって第3コンピュータ33が反射鏡2を切り換え、レジスト除去信号を第2コンピュータ32に送出すると、すぐにシャッタ11の開閉を

0から位置合せ完了信号が得られるまでステージ 26、28を移動する。第2コンピュータ32は 第3コンピュータ33からのレジスト除去モード である旨の指令を受けており、アライメント検出 手段30から位置合せ完了信号が得られると、ス テージ28の移動を停止し、シャッタ11を所定 時間開放する。第2コンピュータ32はシャッタ 11が閉成されると、第1チップのアライメント マーク上のレジストを除去した旨の信号を第3コ ンピュータ33に送出する。第3コンピュータ3 3 はこの信号によって、反射鏡 2 を露光が行なわ れるように設定し、反射鏡2の切り換えが終わる と第1コンピュータ31に露光開始信号を送出す る。第1コンピュータ31は、駆動装置34にス テージ26が初期位置にくるよう指令し、さらに、 アライメント装置35から、アライメントマーク 7による位置合せが完了した旨の信号を受けると ステージ26を停止する信号を移動装置34に送 出するのであるが、露光開始信号が入力されたと き、位置合せが完了した旨の信号が入力されてい

制御することができる。

以下、あらかじめ設定された数のチップに対する露光及び全てのアライメントマークに対するレジスト除去が行なわれるまで、露光とレジスト除去とが繰り返される。

なお、露光に係る構成は、レジスト除去とのシーケンス上の係わりを除けば全て従来の技術をそのまま用いることができる。

以上の第1実施例として示した第1図では、レジスト除去のための光学系を簡略化してその原理のみを示したが、実際にはアライメントマークはX、Yの2方向及び回転補正を行なうために、1つのチップに対して2つ以上設けられている。そこで、2つ以上のアライメントマーク上のレン部件では最去するようにした光学系の主要部件で関を第3図に示す。第3図中、第1図と同符号のものは同じ部材であることを示す。

可動反射鏡 2 からの反射光は、反射鏡 9 で反射 した後、ピームスプリッタ 1 0 へ入射する。ピー ムスプリッタ 1 0 の透過光は、シャッタ 1 1 へ至

る。シャッタ11が開いていれば、シャッタ11 の通過光は絞り12の開口を通ってダイクロイッ ク反射鎖13で反射される。この反射光は集光レ ンズ14、反射鏡15を介してチップCP: のX 方向アライメントマーク16上に集光される。ダ イクロイック反射鏡13は、レーザ1の発振線の 波長の光を反射し、それよりも波長の長い光を透 過するもので、X方向アライメントマーク16は、 反射鏡15、集光レンズ14、ダイクロイック反 射鏡13を介して、観察装置17によって観察さ れる。観察装置17は照明用光源を内蔵し、光学 系1.3、14、15を介してファインアライメン トマーク16を照明してもよく、またレーザ1の 照明によりファインアライメント16上のレジス トから発生する蛍光を検出してもよい。また、こ の2つを適宜切替えられるようにしてもよい。

ビームスプリッタ10での反射光は、シャッタ 18に至る。シャッタ18開いていれば、シャッタ18の通過光は絞り19の開口を通ってダイクロイック反射鏡13で反射される。この反射光は

次に第4図に本発明の第3実施例を示す。第1 図と同符号のものは同じ機能を有するものである。 第4図の実施例が第1図の実施例と異なる点は、 第1図の実施例は、露光中のウェハとは異なるウェハにおけるアライメントマーク上のレジスト除 去を行なうのに対し、第4図の実施例は、露光中のウェハにおけるアライメントマーク上のレジスト除去を行なっていることである。

ビームスプリッタ 2 は透過光路を露光光路、 反射光路をレジスト除去光路としている。勿論、 ビームスプリッタ 2 の代わりに第1図で用いた 如き可動反射鏡を用いても構わない(逆に、第1 図の可動反射鏡 2 はピームスプリッタに置き換え ることができる)。

そして、露光光路中に配設した光学部材3、4、5、6、7、8は第1図の実施例と全く同じである。レジスト除去光路中の光学部材9、11、12、14、15も第1図の実施例と全く同じである。異なるのは、投影レンズ8とレジスト除去光路中の光学部材9、11、12、14、15が一

集光レンズ 2 1、 反射鏡 2 2 を介してチップ C P 。 の Y 方向 アライメントマーク 2 3 上に 集光される。 ダイクロイック 反射鏡 2 0 は、 1 3 と同じもので、 Y 方向 アライメントマーク 2 3 は、 反射鏡 2 2、 集光レンズ 2 1、 ダイクロイック 反射鏡 2 0 を介して、 観察装置 2 4 によって観察される。

第3図の光学系によれば、2つのアライメントマークに対して同時に除去動作が行なわれるので、スループットが向上する。必要に応じてさらに光を分割し、3つ以上のアライメントマークを同時に除去するようになすこともできる。ウェハ上での、光スポットの位置及びレジストの除去の様子は、観察装置17、24によってモニターされる。

なお、アライメントマーク16、23かどこに 打たれていても対応可能なように、部材13、1 4、15、17を一体に保持した保持部材、及び 部材20、21、22、24を一体に保持した保 持部材をそれぞれX方向、Y方向へ移動自在に移 動装置に保持させれば、種類の異なるウェハにも 対応できて好都合である。

体の関係にあって、その位置関係は、露光のため、でなって、といか行なわれたとき、、かま光出のため、レップスト除去光路による光スポットが露光中のあるアライメントであるアライスといって、でいる。露光のアライメントではないではない。では、グローバルアライメントによっている。ないがは、グローバルアライメントによっている。 光とレジスト除去とを同時に行ない、不可能なればいずれか一方のみを行なえば良い。

なお、レジスト除去光路中の光学部材を第3図 のように、複数のファインアライメントマークを 同時に除去できるようにすればより効果的である。

さらに、レチクルと位置合せされているチップ を囲む複数のチップのファインアライメントマー クのそれぞれに対して光スポットが生するように、 レジスト除去のための光学部材を多数組、投影レ ンズ8のまわりに配設しても良い。それらによる 光スポットは、シャックの開閉制御により適宜選 択して生じさせるようにすれば、不必要な箇所の 光スポットが生じていることによる問題点を回避 することができる。 具体的にはウェハの損傷、光 スポットの光量減少等を抑えることになる。

(発明の効果)

以上のように本発明によればスループットをほとんど低下させずに露光とレジスト除去を行なえることにより、光源の利用効率を高め、ランニングコストを低下させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例の光学系を側面から見たブロック図、第2図は第1実施例の電気ブロック図、第3図は本発明の第2実施例のレジスト除去光学系の主要部を示す斜視図、第4図は本発明の第3実施例の光学系を側面から見たブロック図、である。

(主要部分の符号の説明)

1 … 露光光源、 2 … 可動反射鏡、 2 ' … ビームスプリッタ、 1 1 … シャッタ、 1 6 、 2 3 … ファインアライメントマーク、 1 9 、 3 0 … アライメ

ントマーク検出手段、32…第2コンピュータ、 33…第3コンピュータ、36…取動装置。

> 出願人 日本光学工業株式会社 代理人 波 辺 隆 男



